

# 高速 CMOS ロジック IC ELM7SH00xB 2入力 NAND ゲート

http://www.elm-tech.com

## ■概要

ELM7SH00xBはCMOS 2入力 NANDゲートです。このICは低電圧で、超高速動作するためバッテリー動作機器、特にノート型コンピュータなどに適しています。低消費電力なのでバッテリー寿命が長くなり、長時間の機器動作が可能です。また内部回路は3段構成でバッファ付きとなっており、広い雑音耐量と安定した出力を達成しています。すべての入力端子は、入力トレラントな回路構成を採用しています。すなわち、プラス側(入力からVddに向かって順方向になる)のダイオードが無い回路構成であるため、電源電圧が加わらない状態で入力に5.5Vの電圧が与えられるケースも許容可能です。

## ■特長

- 74VHC シリーズと同等の電気的特性
- 低消費電流 : Idd=1.0μA(最大)(Top=25°C)
- 広い電源電圧範囲 : 1.65V~5.5V
- 広い入力電圧範囲 : Vih=5.5V(最大)(Vdd=0~5.5V)
- 高速動作 : Tpd=2.7ns(標準)(Vdd=5.0V)
- 小型パッケージ : SOT-25、SC-70-5(SOT-353)
- ELM7S シリーズと同一ファンクション、端子配置

## ■用途

- 携帯電話、デジタルカメラ、PDA等の携帯型電子機器
- PC及びその周辺機器
- 液晶TV、DVDレコーダー/プレイヤー、STB等のデジタル家電
- プリント基板内での回路修正、タイミング調整、ノイズ対策
- 5V系電源から3V系電源への電圧変換(入力トレラント)

## ■セレクションガイド

ELM7SH00xBEL

記号		
a	機能	00: 2入力 NANDゲート
b	パッケージ	M: SOT-25 T: SC-70-5(SOT-353)
c	製品バージョン	B
d	テーピング方向	EL: パッケージ ファイル参照

ELM7SH 00 x B EL  
          ↑  ↑  ↑  ↑  
          a  b  c  d

## ■絶対最大定格値

項目	記号	規格値	単位
電源電圧	Vdd	-0.5~+6.0	V
入力電圧	Vin	-0.5~+6.0	V
出力電圧	Vout	-0.5~Vdd+0.5	V
入力保護ダイオード電流	lik	-20	mA
出力寄生ダイオード電流	lok	±20	mA
出力電流	Iout	±25	mA
VDD/GND電流	Idd, Ignd	±50	mA
許容損失	Pd	150	mW
保存温度	Tstg	-65~+150	°C

# 高速 CMOS ロジック IC ELM7SH00xB 2入力 NAND ゲート

<http://www.elm-tech.com>

## ■推奨動作条件

項目	記号	規格値		単位
電源電圧	Vdd	1.65~5.5		V
入力電圧	Vin	0~5.5		V
出力電圧	Vout	0~Vdd		V
動作温度	Top	-40~+85		°C
遷移時間	tr, tf	Vdd=1.8±0.15V	0~300	ns
		Vdd=2.5±0.2V	0~200	
		Vdd=3.3±0.3V	0~200	
		Vdd=5.0±0.5V	0~100	

## ■端子配列図



## ■DC 電気的特性

項目	記号	Vdd	Top=25°C		Top=-40~+85°C		単位	条件	
			Min.	Max.	Min.	Max.			
入力電圧	Vih	1.8	1.35	-	1.35	-	V		
		2.0	1.50	-	1.50	-			
		3.0	2.10	-	2.10	-			
		5.5	3.85	-	3.85	-			
	Vil	1.8	-	0.45	-	0.45	V		
		2.0	-	0.50	-	0.50			
		3.0	-	0.90	-	0.90			
		5.5	-	1.65	-	1.65			
出力電圧	Voh	1.8	1.70	-	1.70	-	V	Vin=Vil またはVih	loh=-50μA
		2.0	1.90	-	1.90	-			
		3.0	2.90	-	2.90	-			
		4.5	4.40	-	4.40	-			loh=-4mA loh=-8mA
		3.0	2.58	-	2.48	-			
		4.5	3.94	-	3.80	-			
	Vol	1.8	-	0.10	-	0.10	V	Vin=Vih	lol=50μA
		2.0	-	0.10	-	0.10			
		3.0	-	0.10	-	0.10			
		4.5	-	0.10	-	0.10			lol=4mA lol=8mA
		3.0	-	0.36	-	0.44			
		4.5	-	0.36	-	0.44			
入力電流	lin	5.5	-0.1	0.1	-1.0	1.0	μA	Vin=Vdd または GND	
静的消費電流	Idd	5.5	-	1.0	-	10.0	μA	Vin=Vdd または GND	

# 高速 CMOS ロジック IC ELM7SH00xB 2入力 NAND ゲート

http://www.elm-tech.com

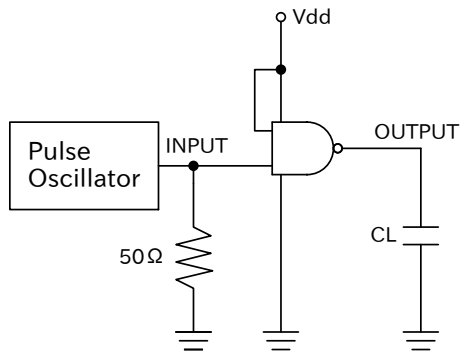
## ■AC 電気的特性

tr=tf=3ns

項目	記号	Vdd	CL	Top=25°C			Top=-40~+85°C		単位	条件
				Min.	Typ.	Max.	Min.	Max.		
伝播遅延時間	tPLH	1.8±0.15	15	-	12.7	23.1	1.0	25.5	ns	試験回路参照
	tPHL			-	12.7	23.1	1.0	25.5		
	tPLH	1.8±0.15	50	-	18.7	33.4	1.0	37.0		
	tPHL			-	18.7	33.4	1.0	37.0		
	tPLH	2.5±0.2	15	-	7.1	12.9	1.0	15.0		
	tPHL			-	7.1	12.9	1.0	15.0		
	tPLH	2.5±0.2	50	-	9.6	16.6	1.0	20.0		
	tPHL			-	9.6	16.6	1.0	20.0		
	tPLH	3.3±0.3	15	-	3.7	7.9	1.0	9.5		
	tPHL			-	3.3	7.9	1.0	9.5		
	tPLH	3.3±0.3	50	-	5.4	11.4	1.0	13.0		
	tPHL			-	4.6	11.4	1.0	13.0		
	tPLH	5.0±0.5	15	-	2.7	5.5	1.0	6.5		
	tPHL			-	2.5	5.5	1.0	6.5		
	tPLH	5.0±0.5	50	-	3.6	7.5	1.0	8.5		
	tPHL			-	3.5	7.5	1.0	8.5		
入力容量	Cin	5.0	-	-	2.0	10.0	-	10.0	pF	Vin=Vdd or GND
等価内部容量	Cpd	-	-	-	9.3	-	-	-	pF	f=1MHz

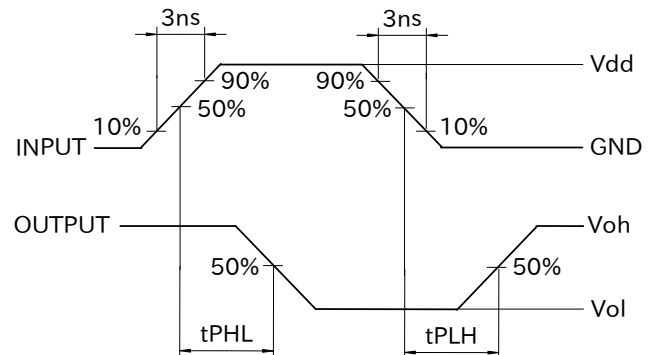
\* Cpd は IC の内部等価容量で、下記の試験回路に対応する無負荷動作消費電流から計算される。無負荷時の平均動作消費電流は次の式で計算できる： $I_{dd}(opr) = Cpd \times Vdd \times fin + I_{dd}$

## ■試験回路

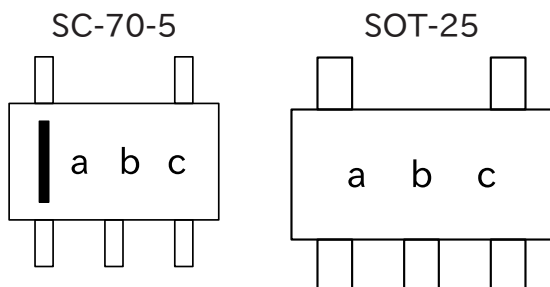


\* 消費電力の測定時、出力は無負荷

## ■測定波形



## ■マーキング



記号	マーク	内容
a	F	ELM7SH シリーズ
b	1	ELM7SH00xB
c	A~Z (I, O, X を除く)	ロット番号